

**2Т3511 – NPN силициев планарно-эпитаксиален  
маломощен транзистор – BG  
корпус С65 (ТО-92)**

**маса max – 0,4 g**

**група Б**

- $U_{св\ max} = 20\ V$
- $U_{ев\ max} = 5\ V$
- $U_{се\ max} = 18\ V$
- $I_c\ max = 100\ mA$
- $P_c\ max = 200\ mW$
- $f_t = 120\ MHz\ (min) - U_{се} = 10\ V; I_c = 10\ mA; f = 100\ MHz$
- $C_{тс} = 6\ pF\ (max) - U_{се} = 10\ V; I_e = 0\ mA; f = 1\ MHz$
- $h_{11e} = 4\ k\Omega$
- $h_{12e} = 1,1 \cdot 10^{-4}$
- $h_{21e} = \beta = 20\ (min) \div 200\ (max) - U_{се} = 10\ V; I_e = 1\ mA; f = 1\ kHz$
- $h_{22e} = 14\ \mu S$
- $U_{(BR)CEO} = 18\ V; I_e = 100\ \mu A; I_c = 0\ \mu A$
- $I_{сво} = 50\ \mu A - U_{cb} = 10\ V; I_e = 0\ \mu A$
- $I_{сво} = 50\ \mu A - U_{cb} = 20\ V; I_e = 0\ \mu A$
- $I_{ево} = 1\ \mu A$
- $I_{ево} = 20\ \mu A - U_{eb} = 1\ V; I_c = 0\ \mu A$
- $I_{ево} = 10\ \mu A - U_{eb} = 5\ V; I_c = 0\ \mu A$
- $t_j\ max = 125\ ^\circ C$
- $t_{stg} = -25\ ^\circ C \div +100\ ^\circ C$
- цокъл 7